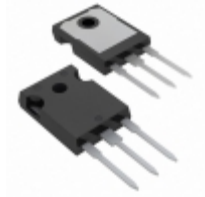


specificazioni	
Modello di prodotti	AOK20S60L
fabbricante	Alpha and Omega Semiconductor, Inc.
Descrizione	MOSFET N-CH 600V 20A TO247
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	1118 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	4.1V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	TO-247
Serie	aMOS™
Rds On (max) a Id, Vgs	199 mOhm @ 10A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	266W (Tc)
imballaggio	Tube
Contenitore / involucro	TO-247-3
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Through Hole
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	1038pF @ 100V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	19.8nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Tensione drain-source (Vdss)	600V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	20A (Tc)

 AOK20B65M2 MOS AO AO TO-247	 AOK22N50L Alpha & Omega Semiconductor Inc. MOSFET N-CH 500V 22A TO247	 AOK22N50 AOS AOK22N50 AOS	 AOK2500 AOS AOS TO-3P
 AOK20N60 AOS AOK20N60 AOS	 AOK20B65M2 Alpha & Omega Semiconductor Inc. IGBT 650V 20A TO247	 AOK20S60 AOS AOK20S60 AOS	 AOK20N60L Alpha & Omega Semiconductor Inc. MOSFET N-CH 600V 20A TO247

Di Più

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited